

(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(51) Int. Cl. ⁷ H05B 33/00	(11) 공개번호 10-2001-0039961	(43) 공개일자 2001년05월 15일
(21) 출원번호 10-2000-0057639		
(22) 출원일자 2000년09월30일		
(30) 우선권주장 99-279870 1999년09월30일 일본(JP)		
(71) 출원인	가부시키가이샤 한도오따이 에네루기 켄큐쇼 야마자키 순페이	
(72) 발명자	일본국 가나가와켄 아쓰기시 하세 398 야마자키순페이 일본가나가와켄아쓰기시하세398가부시키가이샤한도오따이에네루기켄큐쇼내 아라이야스유키	
(74) 대리인	일본가나가와켄아쓰기시하세398가부시키가이샤한도오따이에네루기켄큐쇼내 이병호	

심사청구 : 없음

(54) 유기 이엘 표시 장치

요약

단결정 반도체 기판 위에 형성된 절연 게이트 전계 효과 트랜지스터들이 유기 EL 층과 겹치는, 액티브 매트릭스형의 유기 EL 표시 장치는, 상기 단결정 반도체 기판(도4의 413)이, 절연 재료로 형성된 대판(401) 및 덮개판(405)과, 상기 대판 및 상기 덮개판을 결합시키는 패킹 재료(404)에 의해 규정되는 비워 있는 공간(414) 내에서 유지되며, 상기 비워 있는 공간(414)은 비활성 가스 및 건조제로 채워지는 것을 특징으로 하며, 이에 의해 상기 유기 EL 층의 산화가 방지된다.

대표도

도1

색인어

액티브 매트릭스형 유기 EL 표시 장치, 단결정 반도체 기판, 절연 게이트 전계 효과 트랜지스터, 유기 EL 층, 대판, 덮개판, 패킹 재료, 비활성 가스, 건조제

명세서

도면의 간단한 설명

- 도 1은 액티브 매트릭스형의 유기 EL 표시 장치의 단면도.
- 도 2(a) 및 2(b)는 각각 유기 EL 표시 장치의 픽셀부의 평면도 및 회로 구성도.
- 도 3은 액티브 매트릭스형 유기 EL 표시 장치의 평면도.
- 도 4는 유기 EL 표시 장치의 내부 구조 단면도.
- 도 5는 유기 EL 표시 장치가 설치된 고글형 표시 장치의 구조를 도시하는 사시도.
- 도 6(a) 및 6(b)는 유기 EL 표시 장치가 설치된 고글형 표시 장치의 단면도.

*도면의 주요 부호에 대한 설명

- 101 : 기판
- 102 : p 웰
- 103 내지 105 : n 웰
- 106 : 필드 산화막
- 107 : LDD(p)
- 108 : 소스(p)
- 109 : 드레인(p)
- 113, 119, 125 : LDD(n)
- 114, 120, 126 : 소스(n)
- 115, 121, 127 : 드레인(n)
- 110, 116, 122, 128 : 게이트 절연막
- 111, 117, 123, 129 : 게이트

- 112, 118, 124, 130 : 측벽
- 131 : 제 1 층간 절연막 132 : 제 2 층간 절연막
- 133, 135, 137, 139 : 소스 전극
- 134, 136, 138, 140 : 드레인 전극
- 141 : 패시베이션 막 142 : 제 3 층간 절연막
- 143 : 화소 전극 144 : 음극층
- 145 : EL 층 146 : 양극층

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 단결정 반도체를 활성층으로 사용하는 절연 게이트 전계 효과 트랜지스터들에 기초한 회로를 갖는 반도체 장치 및 그 제조 방법에 관한 것이다. 보다 구체적으로, 본 발명은, 화소부 및 상기 화소부 주위에 배치된 구동 회로들에 동일한 기판이 덮여지는 유기 일렉트로루미네센트 표시 장치(organic electroluminescent display device)로 대표되는 전기 광학 장치 및 상기 전기 광학 장치가 설치되는 전자 장치의 애플리케이션에 매우 적합하다. 부연하여, 본 명세서에서 "반도체 장치"란 반도체 특성을 활용하여 기능하는 전반적인 장치를 가리키며, 상기 전기 광학 장치 및 전기 광학 장치를 탑재하는 전자 장비를 그 범주 내에 포함한다.

액정 표시 장치 및 유기 EL(electroluminescent) 표시 장치로 대표되는 평면 표시 장치(평면 패널 디스플레이) 분야에서, 단결정 반도체 기판 위에 형성된 절연 게이트 전계 효과 트랜지스터들(이후 "전계 효과 트랜지스터들"을 간단히 "FETs"라 한다)을 사용하여 액티브 매트릭스형 표시 장치를 제조하는 기술이 공지되어 있다. 유기 기판 또는 석영 기판 위에 박막 트랜지스터들(이후 간단히 "TFTs"라 한다)을 형성하여 액티브 매트릭스형 표시 장치를 제조하는 경우와는 달리, 상기 기술에서는, 대규모 집적 회로(LSIs)의 분야에서 사용된 기술을 그대로 적용할 수 있고, 고속으로 저전압 구동이 가능한 고성능의 TFTs를 기판 위에 고밀도로 집적하여 형성할 수 있다는 이점이 있다. 그렇지만 다른 한편, 기판이 가시광을 통과시키지 못하기 때문에 상기 표시 장치는 반사형 또는 자체 발광형에 제한되고, 단결정 반도체 기판이 시장에서 유용가능한 크기에 대해 제한된다는 단점이 고려되어 왔다.

표시 장치의 분야에서 고화질화 및 완전 디지털화로의 기술 지향에 있어서, 상기 액티브 매트릭스형 표시 장치에 요구되는 성능 향상은 피할 수 없게 높아지고 있다. 그래서 화상을 표시하는데 하나의 화소부에 수십 내지 수백만 개의 트랜지스터(예를 들어 TFTs 또는 FETs)를 배열하고, 상기 트랜지스터들에 화소 전극들을 각각 접속시켜 상기 액티브 매트릭스형 표시 장치를 제조한다. 동작에 있어서, 각각의 화소에 인가되는 전압을 대응하는 트랜지스터들의 스위칭 기능에 의해 제어하고, 이에 의해 몇몇 EL 소자를 발광하게 하는 방식으로 해서 화상을 표시한다. 유기 EL 표시 장치에 있어서, 각각의 화소에 배치된 스위칭 트랜지스터들이 ON 으로 턴되면, 화상 데이터에 따라 발생된 신호들에 의해 전류 제어 트랜지스터들에 전류가 흐르게 되고, 이에 의해 EL 소자들이 자기 발광한다.

그렇지만, 상기 유기 EL 표시 장치의 기본 부분의 역할을 하는 유기 EL 층이 산화에 대해 매우 약하여, 소량의 산소만 있어도 쉽게 저하된다. 이 이외에도, 열에 약하며 이것도 또한 산화를 조장하는 요인이다. 산화에 대해 약하다는 결정은 유기 EL 소자의 수명을 단축시키는 원인이 되며, 상기 소자를 실제로 사용하는데 있어서 중대한 장애로 된다.

발명이 이루고자하는 기술적 과제

본 발명의 목적은 위에서 언급한 문제를 극복하여 고신뢰성의 유기 EL 표시 장치를 제공하는 것이다.

본 발명의 다른 목적은 그러한 유기 EL 표시 장치를 표시부에 적용하여 상기 표시부의 신뢰성이 높은 전자 장치를 제공하는 것이다.

상기 목적들을 달성하기 위한 본 발명의 구성은, 액티브 매트릭스형 유기 EL 표시 장치에 있어서, 단결정 반도체 기판 위에 형성된 절연 게이트 전계 효과 트랜지스터들 위에 유기 EL 층이 형성되며, 상기 단결정 반도체 기판은 절연 재료로 형성된 대판 및 덮개판과, 상기 대판 및 덮개판을 결합시키는 패키징 재료에 의해 규정되는 비워 있는 공간 내에서 유지되며, 상기 비워 있는 공간은 비활성 가스 및 건조제로 채워지는 것을 특징으로 한다.

또한, 본 발명의 구성은, 화소부를 갖는 액티브 매트릭스형 유기 EL 표시 장치에 있어서, 단결정 반도체 기판 위에 형성된 절연 게이트 전계 효과 트랜지스터들 위에 유기 EL 층이 형성되며, 상기 단결정 반도체 기판은 절연 재료로 형성된 대판 및 덮개판과, 상기 대판 및 덮개판을 결합시키는 패키징 재료에 의해 규정되는 비워 있는 공간 내에서 유지되며, 상기 덮개판은 상기 화소부와 겹치는 영역에서 투명성 부재로 형성되며, 상기 비워 있는 영역은 비활성 가스 및 건조제로 채워지는 것을 특징으로 한다.

단결정 실리콘 반도체는 단결정 반도체 기판으로 양호하게 사용될 수 있다. 이 이외에도, 상기 비워 있는 영역은 헬륨, 아르곤, 크립톤, 크세논 및 질소로 구성되는 족으로부터 선택된 비활성 기체와, 산화바륨 및 실리카 겔로 구성되는 족으로부터 선택된 건조제로 양호하게 채워진다.

발명의 구성 및 작용

먼저, 본 발명에 따른 유기 EL 표시 장치에 대해 도 1을 참조해서 설명한다. 본 발명에 따른 상기 유기 EL 표시 장치는 화소부와 상기 화소부 주위의 구동 회로가 단결정 반도체 기관(예를 들어, 단결정 실리콘 기관) 위에 형성되는 절연 게이트형의 전계 효과 트랜지스터(FETs)를 사용해서 배치되는 구조를 갖는다.

기관(101)은 비교적 높은 저항(예를 들어, n형에서 약 $10[\Omega\text{cm}]$)을 갖는 단결정 실리콘으로 이루어지며, 그 내부에 p 웰(102) 및 n 웰들(103 내지 105)이 자기 정렬된다. 이웃하는 FET들은 필드 산화막(106)에 의해 격리된다. 상기 필드 산화막(106)의 형성에 있어서, 상기 기관(101)의 선택된 부분들에 붕소(B)를 이온 주입에 따라 주입해서 채널 스톱퍼를 형성할 수 있다.

게이트 절연막(110, 116, 122 및 128)을 열 산화법으로 형성한다. 게이트(111, 117, 123 및 129)는 다결정 실리콘 막으로부터 100 내지 300[nm]의 두께로 CVD에 의해 형성된 다결정 실리콘 층(111a, 117a, 123a 및 129a)로 구성되며, 그 위에 실리사이드 층(111b, 117b, 123b, 및 129b)이 각각 형성된다. 상기 다결정 실리콘 층들은 저항을 낮추기 위해 사전에 $10^{21}[\text{cm}^{-3}]$ 의 농도에서 인(P)으로 도핑될 수 있거나, 상기 다결정 실리콘 막이 형성된 후 고농도의 n형 불순물이 확산될 수 있다. 상기 실리사이드 층이 재료로는 몰리브덴 실리사이드(MoSi_x), 텅스텐 실리사이드(WSi_x), 탄탈륨 실리사이드(TaSi_x), 티타늄 실리사이드(TiSi_x) 등을 사용할 수 있으며, 상기 실리사이드 층들은 공지의 방법으로 잘 형성될 수 있다.

p 채널 FET(210)의 저농도 드레인(LDD) 영역들(107)은 1×10^{13} 내지 $1 \times 10^{14}[\text{cm}^{-2}]$ 의 도즈량으로 불순물 원소로서 붕소(B)로 도핑되며, 상기 불순물 원소는 p형의 전도성을 제공한다. 한편, n 채널 FET(202)의 LDD 영역들(113)과, 스위칭 FET(203)의 LDD 영역(119 및 125)과, n 채널 FET로 이루어진 전류 제어 FET(204)는 p형의 도즈량과 유사한 도즈량으로 불순물 원소로서 인(P) 또는 비소(As)로 도핑되며, 상기 불순물 원소는 n형의 전도성을 제공한다. 이들 LDD 영역들은 대응하는 게이트들을 마스크로서 사용하여 이온 주입법 또는 이온 도핑법에 따라 자기 정합으로 각각 형성된다.

상기 LDD 영역들을 형성한 후, 실리콘 산화막 또는 실리콘 질화막과 같은 절연막이 결과적인 기관위 전체 표면 상에 CVD 법에 의해 형성되고, 상기 절연막이 이방성 드라이 에칭법에 의해 그 전체 영역에 대해 불균일하게 에칭되어, 대응하는 게이트들의 측벽들 위에 남겨지게 되는 방식으로 측벽 스페이서(112, 118, 124, 및 130)가 형성된다. 상기 대응하는 측벽 스페이서들을 마스크로서 사용하여 소스 각각의 FETs의 소스 영역들과 드레인 영역들을 형성한다. 보다 구체적으로, p채널 FET(201)의 소스 영역(108) 및 드레인 영역(109)을 5×10^{14} 내지 $1 \times 10^{16}[\text{cm}^{-2}]$ 의 도즈량으로 붕소(B)를 이온 주입하여 형성한다. n 채널 FET(202), 및 상기 n 채널 FET로 이루어진 스위칭 FET(203) 및 전류 제어 FET(204)는, 소스 영역(114), (120 및 126), 및 드레인 영역(115), (121 및 127)에 5×10^{14} 내지 $1 \times 10^{16}[\text{cm}^{-2}]$ 의 도즈량으로 비소(As) 이온 주입함으로써 각각 형성된다.

플라즈마 CVD 법 또는 감압(low-pressure) CVD 법에 의해 양호하게 제조된 실리콘 산화막, 산화 실리콘 질화막 등에 100 내지 2000 nm의 두께로 제 1 층간 절연막을 형성한다. 또한, 상기 제 1 층간 절연막 위에 인규산염 유리(PSG), 붕소규산염 유리(BSG), 또는 인붕소규산염 유리(PBSG)로 이루어진 제 2 층간 절연막(132)이 형성된다. 상기 제 2 층간 절연막(132)은 스펀 코팅법 또는 정상 CVD법으로 제조된다. 상기 제조된 막은, 700 내지 900[°C]에서 열활성화 처리에 의해 리플로우(reflow)되고, 이것은 제조 후 실행되면서 열처리로도 가능하며, 이에 의해 상기 제 2 층간 절연막의 표면은 평탄화된다.

상기 대응하는 FETs의 소스 영역들과 드레인 영역들에 도달하는 접촉 구멍들을 상기 제 1 층간 절연막과 상기 평탄화된 막(132)에 형성한 후, 소스 배선(133, 135, 137 및 139) 및 드레인 배선(134, 136, 138 및 140)을 각각 형성한다. 통상적으로 저저항 재료로서 종종 사용하는 알루미늄(Al)을 상기 배선에 사용한다. 대안으로, Al 층과 티타늄(Ti) 층으로 구성되는 다층 구조체를 상기 배선 각각에 사용할 수도 있다.

패시베이션 막(141)을 CVD 법에 의해 실리콘 질화막, 실리콘 산화막 또는 질화 실리콘 산화막으로 형성한다. 또한, 제 3 층간 절연막(142)을 유기 수지 재료로 1 [μm] 내지 2 [μm]의 두께로 형성한다. 상기 유기 수지 재료로서는, 폴리이미드 수지, 폴리아미드 수지, 아크릴 수지, 벤젠-시클로-부탄(BCB) 중 임의의 것이 될 수 있다. 상기 유기 수지 재료를 사용하는 장점은, 막을 형성하는 방법이 간단하다는 것과, 비교적 낮은 절연 상수로 인해 기생 용량이 낮아질 수 있다는 것과, 상기 재료가 평탄화에 적합하다는 것이다. 물론, 위에서 언급한 것과는 다른 유기 수지 막이 사용될 수도 있다. 본 문헌에서는, 결과적인 기관 상에 사용되어 열 중합에 의해 처리되는 형태의 폴리이미드 수지를 사용하여 클린 오븐(clean oven)에서 300[°C]에서 굽는다.

상기 전류 제어 FET(204)의 드레인 배선에 화소 전극(143)이 접속된다. 상기 화소 전극(143)은 Al로 대표되는 저저항 재료로 형성된다. Al 막은 공지의 막 형성 방법, 예를 들어 진공 증착법 또는 스퍼터링 법으로 쉽게 형성될 수 있다. 콘트라스트를 향상시키기 위해, 상기 화소 전극(143)의 표면을 거칠게 하여 확산 반사 표면(diffusing reflective surface)으로 한다.

상기 화소 전극들(143)을 형성한 후, 모든 화소 전극들 위에 일함수(work function)가 낮은 금속을 포함하는 음극층(144)을 형성한다. 상기 음극층(144)은 수 nm으로 얇기 때문에, 층이 진짜로 형성되든지 또는 층이 산발적으로 섬 모양으로 형성되는지가 불명확하며, 그래서 그 윤곽을 점선으로 표시한다.

일함수가 낮은 금속을 포함하는 음극층(144)으로서 사용가능한 재료로서는, 리튬 불화물(LiF), 리튬 산화물(Li₂O), 바륨 불화물(BaF₂), 바륨 산화물(BaO), 칼슘 불화물(CaF₂), 칼슘 산화물(CaO), 스트론튬 산화물(SrO) 또는 세슘 산화물(Cs₂O)이 있다. 상기 재료는 절연성이기 때문에, 상기 음극층(144)이 접속층

일지라도 화소 전극들간에 단락 회로가 발생하지 않는다. 물론, MgAg 전극과 같은 전도성을 갖는 공지의 재료로 이루어진 음극층이 상기 음극층으로서 사용될 수 있다. 그렇지만, 선택적으로 음극층을 형성하거나 패턴화를 실행하여, 상기 화소 전극들이 단락 회로가 되는 것을 방지할 필요가 있다.

일함수가 낮은 금속을 포함하는 음극층(144) 위에 유기 EL(electro^Luminescent) 층(145)을 형성한다. 공지의 재료 또는 구조체를 상기 유기 EL 층(145)을 형성하는데 사용할지라도, 백색 발광이 가능한 재료가 본 발명에 사용된다. 구조적으로, 상기 유기 EL 층(145)을 재결합 위치를 제공하는 발광층으로만 형성할 수 있다. 필요하다면, 그 위에 전자 주입층, 전자 수송층, 정공 수송층, 전자 차단층, 정공 차단층 또는 정공 주입층을 적층하는 것도 가능하다. 본 명세서에 있어서, 캐리어가 주입, 수송 또는 재결합되는 모든 층을 "유기 EL 층"으로 칭한다.

또한, 유기 EL 층(145)에 사용되는 유기 EL 재료는 중합체에 기초한 고분자계 유기 EL 재료이다. 예를 들어, PVK(폴리비닐 카바졸), Bu-PBD(2-(4'-tert-부틸페닐)-5-(4"-비페닐)-1, 3, 4-옥사디아졸), 커마린 6, DCM 1(4-디시아노메틸렌-2-메틸-6-p-디메틸아미노스티릴-4H-피란), TPB(테트라페닐부타디엔) 및 나일 레드(Nile red)를 1,2-디클로로메탄 또는 클로로포름에 용해하고 그래서 얻어진 용액에 스프인 코팅법을 적용한다. 상기 용액으로 코팅된 기판 구조체를 약 500 내지 1000[rpm]의 회전 주파수에서 20 내지 60[초]동안 회전시켜 균일한 코팅막을 형성한다.

물론, 상기 코팅막은 상기 유기 EL 층이 적어도 3회, 양호하게는 5회 이상 정제(통상적으로, 투근법(dialyzing))된 후 형성되며, 이에 의해 상기 재료의 소듐 농도(sodium content)가 0.1[ppm] 이하(양호하게는, 0.01[ppm] 이하)로 낮아진다. 그래서, 상기 유기 EL 층(349)의 소듐 농도는 0.1[ppm] 이하(양호하게는, 0.01[ppm] 이하)로 되며, 그 체적 저항은 1×10^{11} 내지 1×10^{12} [Ω cm](양호하게는, 1×10^{12} 내지 1×10^{13} [Ω cm])으로 된다.

이 방법으로 형성된 유기 EL 표시 장치 위에 투명 전도막이 양극층(146)으로서 형성된다. 상기 투명 전도막으로서, 인듐 산화물 및 아연 산화물로부터 생성된 화합물(ITO라 칭함), 인듐 산화물, 아연 산화물, 주석 산화물(SnO₂), 아연 산화물(ZnO)로부터 생성된 화합물이 사용가능하다.

또한, 상기 양극층(146) 위에 절연막이 패시베이션 막(147)으로서 형성된다. 상기 패시베이션 막(147)으로서 실리콘 질화막 또는 질화 실리콘 산화막("SiO_xN_y"으로 표시함)이 가능하다.

본 명세서에서는 이때까지 완성된 기판 구조체를 "액티브 매트릭스 기판"이라 칭한다. 즉, "액티브 매트릭스 기판"은, FETs, 상기 FETs에 전기적으로 접속된 화소 전극들, 및 화소 전극들을 음극으로서 포함하는 유기 EL 소자(음극층, 상기 유기 EL 층 및 양극으로 구성되는 캐패시터)로 형성되는 기판이다.

도 2(a)는 상기 액티브 매트릭스 기판의 화소부에 대한 평면도이며, 도 2(b)는 상기 화소부의 회로 배열에 대한 접속도이다. 실제로, 상기 화소부(화상 표시부)는 복수의 화소가 매트릭스 모양으로 배열되도록 구성된다. 또한, 도 2(a)에서 A-A'를 따라 절취한 단면도가 도 1의 화소부의 단면도와 대응한다. 따라서, 도 1 및 도 2(a)에서 공통의 도면 부호가 사용되며, 두 도면을 양호하게 참조한다. 또한, 도 2(a)의 평면도에 두 개의 화소가 도시되며, 이 두 개의 화소는 동일한 구조를 갖는다. 도 2(b)에 도시된 바와 같이, 화소 당 두 개의 FETs가 유기 EL 소자(205)에 설치된다. 상기 두 개의 FETs는 n 채널형이며, 스위칭 FET(203) 및 전류 제어 FET(204)로서 기능한다.

상기 방법에서, 상기 단결정 실리콘 기판 위에는, p 채널 FET(201) 및 n 채널 FET(202)로 구성되는 CMOS 회로를 각각 기본으로 하는 구동 회로들과, n 채널 FET로 형성된 스위칭 FET(203) 및 전류 제어 FET(204)를 각각 구비하는 화소부들이 형성된다. 상기 CMOS 회로를 기본으로 한 구동 회로는 예를 들어 시프트 레지스터 회로, 버퍼 회로, 샘플링 회로, D/A 변환기 및 래치 회로를 형성할 수 있다. 그러한 회로들은, 액티브 층들이 단결정 실리콘으로 이루어지는 절연 게이트 FET로 구성되기 때문에, 고속 동작이 가능하며, 구동 전압을 3 내지 5[V]로 설정하여 낮은 전원 소비를 달성할 수 있다. 이 방법에서, 본 실시예에서 설명된 FETs의 구조체는 단순히 예에 지나지 않으며, 상기 FETs는 도 1에 도시된 구조체에 제한되지 않는다.

도 3은 액티브 매트릭스 기판을 도시하는 평면도이다. 도면을 참조하면, 액티브 매트릭스 기판은 기판(1000), 화소부(1001), 데이터 라인측 구동 회로(1003), 및 주사 라인측 구동 회로(1002)를 포함한다. 각각의 구동 회로에 대한 입력 단자는 기판(1000)의 가장자리에 설치된 와이어 본딩용 패드(1006)들이며, 이 패드들은 리드(1004 내지 1005)를 통해 구동 회로들에 접속된다. 화소부의 크기는 0.5 인치 내지 클래스 내지 2.5 인치 클래스가 제조에 적합하다.

상기 유기 EL 층으로 형성된 액티브 매트릭스 기판은 패키지로 봉해져서 외부 충격 및 먼지나 습기로 차단된다. 패키지의 모양이나 방식은 도 4에 예시되어 있다. 세라믹과 같은 절연 재료로 대판(bed plate)(401)을 형성하고, 그 위에 저용점 유리 또는 금속화층(402)에 의해 상기 유기 EL 층이 형성된 액티브 매트릭스 기판(413)이 고정된다. 상기 액티브 매트릭스 기판(403)은 리드 프레임(404)에 의해 외부 회로와 접속되며, 상기 리드 프레임은 와이어 본딩용 패드(410)들을 통해 금(Au)으로 형성된 와이어(412)에 의해 상기 액티브 매트릭스 기판(413)과 접속된다.

상기 액티브 매트릭스 기판(413)은 세라믹 덮개판(cover ceramic plate)(405)으로 봉해진다. 상기 세라믹 덮개판(405)은 바인더 층(404)에 의해 상기 대판(401)과 결합된다. 상기 바인더 층(404)으로서, 파이로세라믹 시멘트(pyroceram cement), 산화 비스무스계 유리(bismuth oxide-based glass), 산화 납계 유리(lead oxide-based glass) 등이 사용된다. 상기 액티브 매트릭스 기판(413) 위에 상기 대판(401)과 유사하게, 세라믹 등의 절연 재료로 이루어진 상기 덮개판(405)이 형성되는 영역에, 투명 석영판, 투명 유리판 등으로 이루어진 장 부재(406)이 접착제(407)로 장착되어 형성된다. 이 방법에서, 상기 유기 EL 층이 형성된 상기 액티브 매트릭스 기판(413)이 밀폐되어, 비워 있는 공간(414)이 형성된다. 또한, 상기 비워 있는 공간(414)은 비활성 가스(예를 들어, 아르곤, 헬륨, 크립톤, 크세논 또는 질소)가 채워지

거나, 건조제(예를 들어, 바륨 산화물)가 그 안에 채워진다. 이 방법에서, 습기 등에 의한 상기 EL 소자의 저하를 방지할 수 있다.

본 실시예에서는 설명하지는 않았지만, 상기 액티브 매트릭스 기판의 유기 EL 층으로부터 형성된 개개의 화소에 대응하여 상기 유기 EL 층 위에 칼러 필터나 흑색 매트릭스 층(광 차단층)을 설치함으로써 칼러 표시도 구성할 수 있다. 대안으로, 도 4에 도시된 창(406)에 칼러 필터를 설치할 수도 있다.

위에서 서술한 바와 같이 도 4에 도시된 상태에서, 상기 리드 프레임(403)은 외부 장비의 단자에 접속되며, 이에 의해 화상 신호 등이 입력되어 상기 화소부 상에 화상을 표시할 수 있다. 본 명세서에서는, 리드 프레임을 외부 회로에 부착시킴으로써, 화상이 표시가능한 상태로 되는 물품을 "유기 EL 표시 장치"로서 규정된다.

이제, 액티브 매트릭스형 유기 EL 표시 장치가 고글형 표시 장치로 사용되는 실제의 예에 대해 설명한다. 도 5는 본 예에서 고글형 표시 장치의 개략도를 도시한다. 상기 고글형 표시 장치의 본체(3600)는 두 개, 즉 좌우 표시부를 가지며, 이 표시부들은 유기 EL 표시 장치(3602R, 3602L), 회로 기판(3603R, 3603L) 및 렌즈(3601R, 3601L)로 구성된다.

도 6(a)는 도 5에 표시된 부분 A의 단면도이고, 도 6(b)는 도 6(a)에 도시된 부분 B의 확대도이다. 도 6(a) 및 도 6(b)에 도시된 바와 같이, 본 예에서는, 상기 고글형 표시 장치(3600)에서, 상기 렌즈(3601R) 위에 장착된 유기 EL 표시 장치(3602R)가 리드 프레임(3606R)을 통해, 신호 제어 회로 등을 구비한 회로 기판(3603R)에 접속된다. 상기 유기 EL 표시 장치(3602R)로부터 발광하는 광은 도 6(a)의 화살표로 지시된 광 경로를 통해 사용자의 안구(3604R)에 도착하고, 이에 의해 사용자는 화상을 인식할 수 있다.

상기 유기 EL 표시 장치는 그 자체적인 발광에 의해 넓은 시야 각을 갖는다. 상기 고글형 표시 장치에 적용될 때, 상기 유기 EL 표시는, 상기 표시 장치와 관찰자의 눈이 상대적으로 어긋나는 경우에도 나빠지지 않는다.

발명의 효과

본 발명은 다음과 같은 효과를 갖는다.

절연 게이트 전계 효과 트랜지스터 및 EL 층이 형성된 단결정 반도체 기판이, 절연 재료로 형성된 대판 및 덮개판과, 상기 대판 및 덮개판을 결합시키는 패키징 재료에 의해 규정되는 비워 있는 공간에서 유지되고, 상기 비워 있는 공간은 비활성 가스 및 건조제로 채워지며, 이에 의해 상기 EL 층의 저하를 방지하여 고신뢰성의 유기 EL 표시 장치를 제공한다.

(57) 청구의 범위

청구항 1

액티브 매트릭스형 유기 EL 표시 장치에 있어서,
 단결정 반도체 기판 위에 제공된 절연 게이트 전계 효과 트랜지스터와,
 상기 절연 게이트 전계 효과 트랜지스터 위에 제공된 유기 EL 층과,
 절연 재료로 형성된 대판(*bed plate*) 및 덮개판(*cover plate*)과,
 상기 대판 및 덮개판을 결합시키는 패키징 재료를 포함하며,
 상기 단결정 반도체 기판은 상기 대판과 상기 덮개판과 상기 패키징 재료에 의해 규정되는 비워 있는 공간 내에 유지되며,
 상기 비워 있는 공간은 비활성 가스 및 건조제로 채워지는 액티브 매트릭스형 유기 EL 표시 장치.

청구항 2

제 1 항에 있어서, 상기 유기 EL 표시 장치는 고글형 표시 장치의 표시부로 사용되는 액티브 매트릭스형 유기 EL 표시 장치.

청구항 3

액티브 매트릭스형 유기 EL 표시 장치에 있어서,
 단결정 반도체 기판 위의 화소부에 제공된 절연 게이트 전계 효과 트랜지스터와,
 상기 절연 게이트 전계 효과 트랜지스터 위에 제공된 유기 EL 층과,
 절연 재료로 형성된 대판 및 덮개판과,
 상기 대판과 덮개판을 결합시키는 패키징 재료를 포함하며,
 상기 단결정 반도체 기판은 상기 대판과 상기 덮개판과 상기 패키징 재료에 의해 규정되는 비워 있는 공간 내에 유지되며,
 상기 덮개판은 상기 화소부와 겹쳐 있는 상기 덮개판의 영역에서 투광성 재료를 포함하며,
 상기 비워 있는 공간은 비활성 가스와 건조제로 채워지는 액티브 매트릭스형 유기 EL 표시 장치.

청구항 4

제 3 항에 있어서, 상기 유기 EL 표시 장치는 고글형 표시 장치의 표시부로 사용되는 액티브 매트릭스형 유기 EL 표시 장치.

청구항 5

액티브 매트릭스형 유기 EL 표시 장치에 있어서,
 단결정 반도체 기판 위의 픽셀부에 제공된 절연 게이트 전계 효과 트랜지스터와,
 상기 절연 게이트 전계 효과 트랜지스터 위에 제공된 유기 EL 층과,
 세라믹 재료로 형성된 대판 및 덮개판과,
 상기 대판 및 덮개판을 결합시키는 패킹 재료를 포함하며,
 상기 단결정 반도체 기판은 상기 대판과 상기 덮개판과 상기 패킹 재료에 의해 규정되는 비워 있는 공간 내에 유지되며,
 상기 덮개판은 상기 픽셀부와 겹치는 상기 덮개판의 영역에서 투광성 재료를 포함하며,
 상기 비워 있는 공간은 헬륨, 아르곤, 크립톤(krypton), 크세논 및 질소로 구성되는 족으로부터 선택된 비활성 기체와, 산화 바륨 및 실리카 겔로 구성되는 족으로부터 선택된 건조제로 채워지는 액티브 매트릭스형 유기 EL 표시 장치.

청구항 6

제 5 항에 있어서, 상기 유기 EL 표시 장치는 고글형 표시 장치의 표시부로 사용되는 액티브 매트릭스형 유기 EL 표시 장치.

청구항 7

액티브 매트릭스형 유기 EL 표시 장치에 있어서,
 단결정 반도체 기판 위에 제공된 절연 게이트 전계 효과 트랜지스터와,
 상기 절연 게이트 전계 효과 트랜지스터 위에 제공된 유기 EL 층과,
 절연 재료로 형성된 대판 및 덮개판과,
 상기 대판 및 덮개판을 결합시키는 바인더 층을 포함하며,
 상기 단결정 반도체 기판은 상기 대판과 상기 덮개판과 상기 바인더 층에 의해 규정되는 비워 있는 공간 내에 유지되며,
 상기 비워 있는 공간은 비활성 기체 및 건조제로 채워지는 액티브 매트릭스형 유기 EL 표시 장치.

청구항 8

제 7 항에 있어서, 상기 유기 EL 표시 장치는 고글형 표시 장치의 표시부로 사용되는 액티브 매트릭스형 유기 EL 표시 장치.

청구항 9

액티브 매트릭스형 유기 EL 표시 장치에 있어서,
 단결정 반도체 기판 위의 픽셀부에 제공된 절연 게이트 전계 효과 트랜지스터와,
 상기 절연 게이트 전계 효과 트랜지스터 위에 제공된 유기 EL 층과,
 절연 재료로 형성된 대판 및 덮개판과,
 상기 대판 및 덮개판을 결합시키는 바인더 층을 포함하며,
 상기 단결정 반도체 기판은 상기 대판과 상기 덮개판과 상기 바인더 층에 의해 규정되는 비워 있는 공간 내에 유지되며,
 상기 덮개판은 상기 픽셀부와 겹치는 상기 덮개판의 영역에서 투광성 재료를 포함하며,
 상기 비워 있는 공간은 비활성 기체 및 건조제로 채워지는 액티브 매트릭스형 유기 EL 표시 장치.

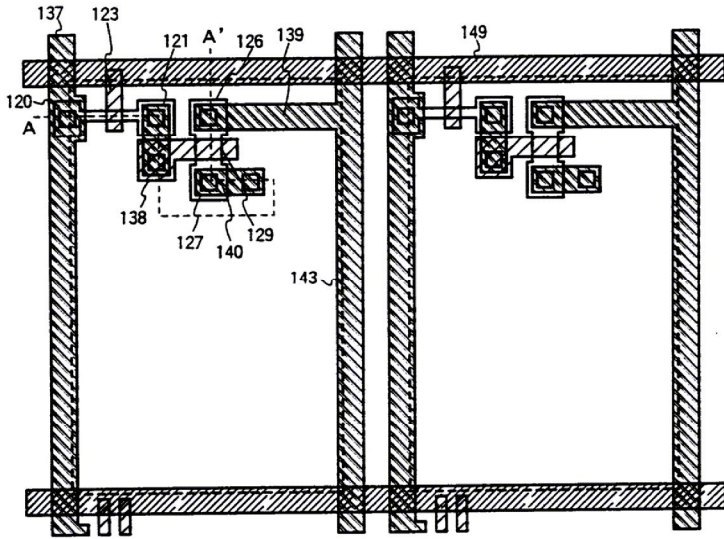
청구항 10

제 9 항에 있어서, 상기 유기 EL 표시 장치는 고글형 표시 장치의 표시부로 사용되는 액티브 매트릭스형 유기 EL 표시 장치.

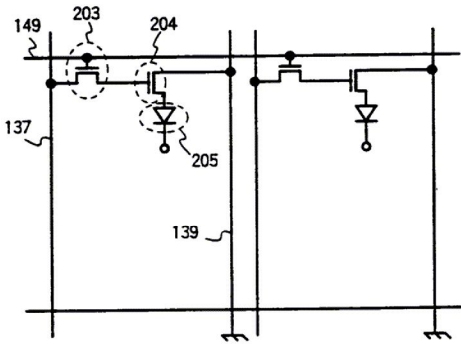
청구항 11

액티브 매트릭스형 유기 EL 표시 장치에 있어서,
 단결정 반도체 기판 위의 픽셀부에 제공된 절연 게이트 전계 효과 트랜지스터와,
 상기 절연 게이트 전계 효과 트랜지스터 위에 제공된 유기 EL 층과,

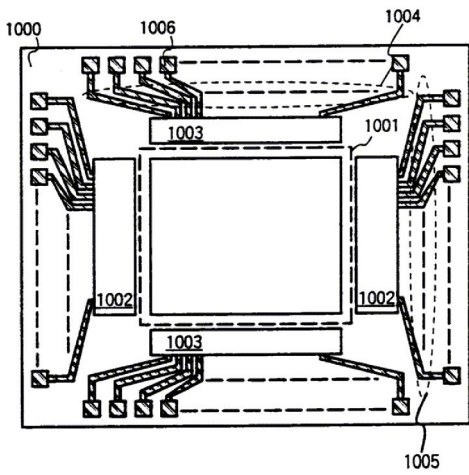
도면2a



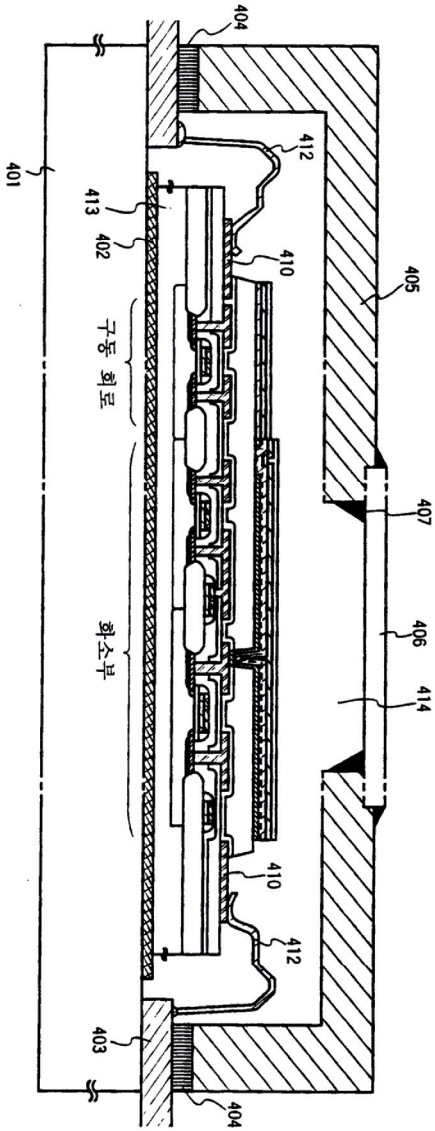
도면2b



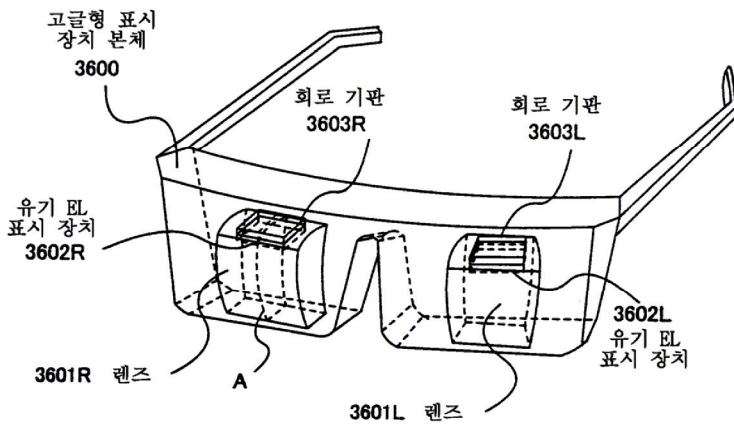
도면3



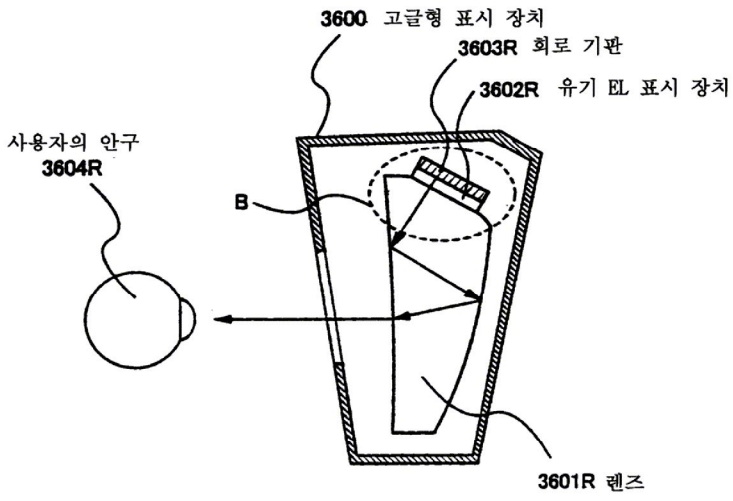
도면4



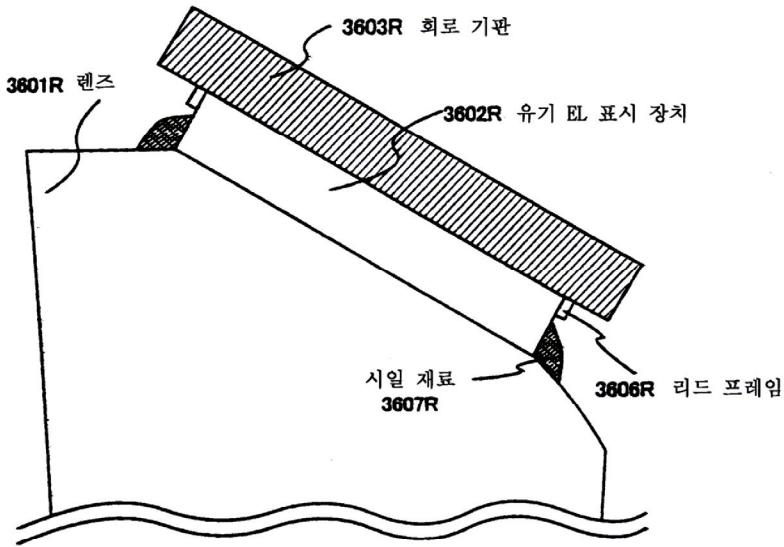
도면5



도면6a



도면6b



专利名称(译)	有机EL显示装置		
公开(公告)号	KR1020010039961A	公开(公告)日	2001-05-15
申请号	KR1020000057639	申请日	2000-09-30
[标]申请(专利权)人(译)	株式会社半导体能源研究所		
申请(专利权)人(译)	株式会社绒布器肯kyusyo极限戴哦		
当前申请(专利权)人(译)	株式会社绒布器肯kyusyo极限戴哦		
[标]发明人	YAMAZAKI SHUNPEI 야마자키순페이 ARAI YASUYUKI 아라이야스유키		
发明人	야마자키순페이 아라이야스유키		
IPC分类号	H01L27/32 H01L51/50 H05B H01L51/52 H05B33/00 H01L27/28 H05B33/04		
CPC分类号	H01L51/5281 H01L51/524 H01L2251/5315 H01L27/3244 H01L51/5275 H05B33/04 H01L51/5259 H01L51/5237		
代理人(译)	李, 何炳 李昌勋		
优先权	1999279870 1999-09-30 JP		
其他公开文献	KR100747418B1		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

它保持在由密封材料 (404) 规定的空的空间 (414) 中, 其中有源矩阵型的有机EL显示装置, 其中在单晶半导体衬底上形成的IGFET被有机电子发光层覆盖支撑板 (401) 和盖板 (405), 其中单晶半导体衬底 (图4中的413) 由绝缘材料和支撑板和盖板形成。并且空的空间 (414) 填充有惰性气体和干燥剂。并且由此防止了有机电子发光层的氧化。有源矩阵型有机EL显示器件, 单晶半导体衬底, IGFET, 有机电子发光层, 支撑板, 盖板, 密封材料, 惰性气体, 干燥剂。

